



## 产品说明

# Pure Storage® DirectMemory Cache

存储级内存可提高应用性能。

### 性能

- 读取延迟降低50%  
(最低可达150 μs)
- 提高阵列处理量

### 容量

- 3TB选配，带四个750GB DirectMemory模块
- 6TB选配，带八个750GB DirectMemory模块

### 阵列支持

- FlashArray//X70R2
- FlashArray//X90R2

组织对让数据产生更多价值的期望永无止境。这个努力的第一步就是机械存储过渡到SAS固态驱动器。随后，企业存储继而向一种全新存储访问方式-NVMe演进。但应用还需要更快的响应时间。传统NAND与本地内存（DRAM）之间的性能差距很大，在成本方面也同样差距巨大，因此存储级内存（SCM）是下一代发展方向。通过Purity Optimize，DirectMemory Cache可轻松改善数据库、分析和报告的性能。

### DirectMemory Cache软件

DirectMemory Cache是核心操作系统Purity for FlashArray™的一部分，采用了全新SCM技术的软件集成。Purity Optimize可以使用Intel Optane自动将阵列中闪存介质中的读操作转移到板载DirectMemory Modules。将DirectMemory Modules无中断地添加到全新或现有的FlashArray//X70R2或//X90R2中，DirectMemory Cache就可以马上开始工作，无需进行配置或调试。随后，阵列就开始为FlashArray工作负载（尤其是联机事务处理（OLTP）和内存数据库）降低延迟，提升处理量。

### 轻松高性能

DirectMemoryCache极大提高了FlashArray//X的性能。目前，通过100%NVMe DirectFlash™和搭载NVMe-oF的DirectFlash Fabric，FlashArray//X实现了250us的延迟表现。利用DirectMemory Cache，读取延迟表现将有可能提高50%，与此同时，还可以提高处理量，系统资源减负效益更佳。

## DirectMemory Modules

您可以即插即用的方式，将DirectMemory Modules轻松安装在FlashArray//X阵列机箱中，还可以在不需间断的情况下将其添加到生产系统的FlashArray中。DirectMemory Cache采用Intel Optane技术实现接近DRAM存储器的延迟速度。与传统DRAM内存相比，它具有持久性的额外优势，同时具有超高的耐用性。您可以用750GB DirectMemory Modules添加3TB或6TB的SCM容量，满足各种需求。

## 其他资源

- [FlashArray//X](#)
- [Pure Storage-什么是存储类内存?](#)
- [FlashArray//X产品说明](#)
- [Purity for FlashArray产品说明](#)

[purestorage.com](https://purestorage.com)

800.379.PURE

